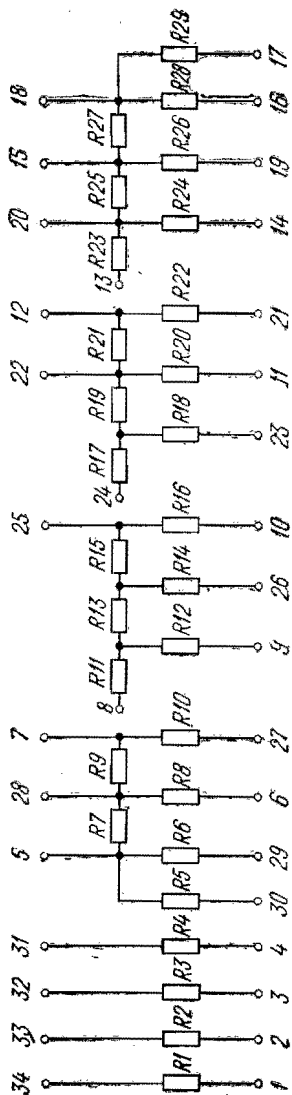


313НР210—
313НР241

ДЕКОДИРУЮЩАЯ РЕЗИСТОРНАЯ МАТРИЦА
ТИПА R—2R

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА



Позицион- ное обозна- чение	Наимено- вание	Позицион- ное обозна- чение	Наимено- вание	Позицион- ное обозна- чение	Наимено- вание
R1	Резистор 2R	R11	R	R20	Резистор 2R
R2	R	R12	2R	R21	R
R3	2R	R13	R	R22	2R
R4	R	R14	2R	R23	R
R5, R6	2R	R15	R	R24	2R
R7	R	R16	2R	R25	R
R8	2R	R17	R	R26	2R
R9	R	R18	2R	R27	R
R10	2R	R19	R	R28, R29	2R

**ДЕКОДИРУЮЩАЯ РЕЗИСТОРНАЯ МАТРИЦА
ТИПА R-2R**

**313НР210—
313НР241**

Значение сопротивления резистора R

Тип микросхемы	Номинальное значение сопротивления, кОм	Предельное отклонение, %
313НР210	5	5
313НР211	5	10
313НР220	10	5
313НР221	10	10
313НР230	20	5
313НР231	20	10
313НР240	50	5
313НР241	50	10

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре 25°С)

Допускаемое отклонение коэффициента деления, %, не более	$\pm 0,0075$
Напряжение на входе, В:	
для микросхем 313НР210, 313НР211	9
» » 313НР220, 313НР221	15
» » 313НР230, 313НР231	24
» » 313НР240, 313НР241	30
Время установления выходного напряжения, мкс, не более	1
Сопротивление изоляции (напряжение измерения 100 В прикладывается между экраном и закороченными выводами), МОм, не менее	1000
Сопротивление резисторов, кОм:	
R, для микросхем	
313НР210	от 4,788 до 5,208
313НР211	от 4,57 до 5,456
313НР220	от 9,574 до 10,410
313НР221	от 9,074 до 10,907
313НР230	от 19,155 до 20,831
313НР231	от 18,147 до 21,822

**313НР210—
313НР241**

**ДЕКОДИРУЮЩАЯ РЕЗИСТОРНАЯ МАТРИЦА
ТИПА R—2R**

313НР240	от 47,879 до 52,079
313НР241	от 45,358 до 54,558
2R, для микросхем	
313НР210	от 9,576 до 10,410
313НР211	от 9,04 до 10,907
313НР220	от 19,155 до 20,832
313НР221	от 18,147 до 21,822
313НР230	от 38,296 до 41,664
313НР231	от 36,294 до 43,645
313НР240	от 95,732 до 103,837
313НР241	от 90,694 до 108,791

**ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

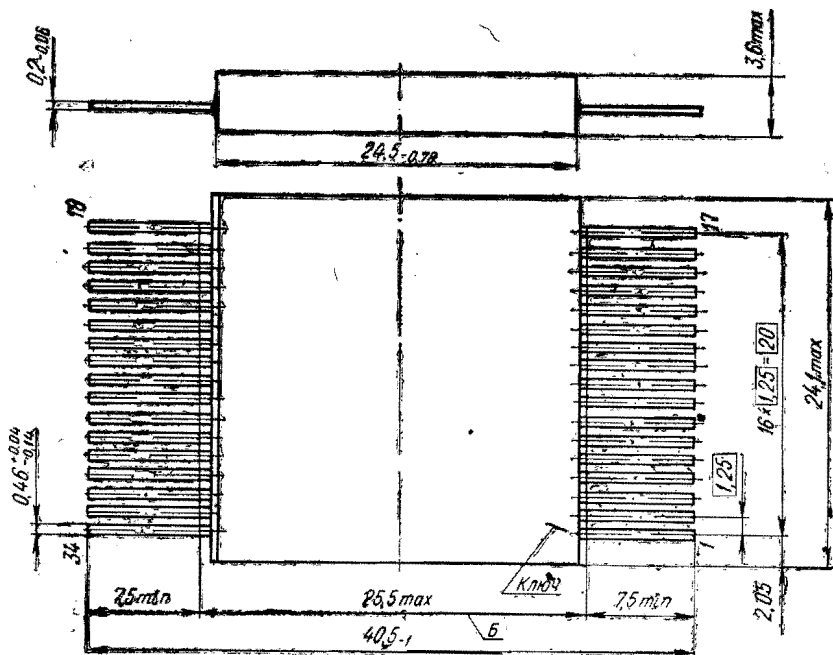
Максимальное входное напряжение, В:

для микросхем 313НР210, 313НР211	9
» » 313НР220, 313НР221	15
» » 313НР230, 313НР231	24
» » 313НР240, 313НР241	30

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 313

Общие данные

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОСТАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ (КОРПУС 4137.34-1)



Масса не более 4,5 г

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц	от 1 до 5000
амплитуда ускорения, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)	400 (40)

Механический удар, одиночного действия:

пиковое ударное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)	15 000 (1500)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 0,1 до 2,0

Механический удар многократного действия:

пиковое ударное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)	1500 (150)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 1 до 5
Линейное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)	5000 (500)

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 313

Общие данные

Акустический шум:

диапазон частот, Гц	от 50 до 10 000
уровень звукового давления, дБ	170
Атмосферное пониженное давление, мм рт. ст. (Па)	10^{-6} ($1,3 \cdot 10^{-4}$)
Атмосферное повышенное давление, атм	3
Повышенная температура среды, °С	100
Пониженная температура среды, °С	минус 60
Изменения температуры среды, °С	от минус 60 до +100

Иней, роса.

Соляной туман.

Среда, зараженная плесневыми грибами.

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка ^О , ч:	
для микросхем 313НР1(А—М)	25 000
для остальных микросхем	15 000
Срок сохраняемости ^О , лет	25

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ В 11 073.041—82 и требованиями, изложенными ниже.

Допустимое значение статического потенциала 100 В.

Допускается эксплуатация микросхем при 100%-ной перегрузке по напряжению с сохранением точностных характеристик в течение времени не более 96 ч.

Допускается эксплуатация микросхем в течение 1 ч при температуре 125°С с увеличением погрешности выходного напряжения до 10%. Температура жала паяльника при распайке микросхем на плату — не более 265°С. Время касания к каждому выводу:

для одножального паяльника — не более 3 с;

для группового паяльника — не более 2 с.

Интервал между пайками соседних выводов — не менее 3 с. Интервал между двумя повторными пайками одной микросхемы — не менее 5 мин.

Микросхемы устанавливаются на платы вплотную. Допускается обрезка недействующих выводов.

Микросхемы после установки их на платы покрываются лаком ЭП-730 ГОСТ 20824—81. Количество слоев—3.

^О В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.